

自主封測 品質把控 售後保障

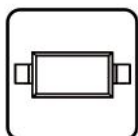
WEB | WWW.TDSEMIC.COM



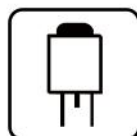
電源管理



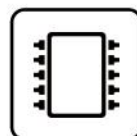
顯示驅動



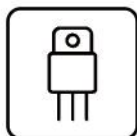
二三極管



LDO穩壓器



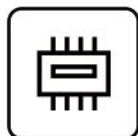
觸摸芯片



MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

KP1505-TD

產品規格說明書

KP1505 PWM控制功率器

概述:

KP1505是一款高性能低成本PWM控制功率器，适用于离线式小功率降压型应用场合，外围电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置高耐压（500V）MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。

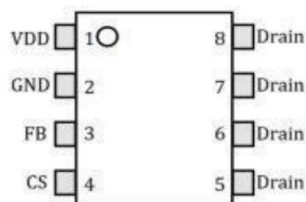
与传统的 PWM 功率开关不同，KP1505内部无固定时钟驱动 MOSFET，系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术，有效简化了外围电路设计，提升线性调整率和负载调整率并消除系统中的可闻噪音。此外，芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节，可以有效降低空载情况下的待机功耗。

KP1505集成有完备的带自恢复功能的保护功能：VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护。

应用:

- 小家电电源
- 工业控制

管脚排列:



SOP8俯视图

包装信息:

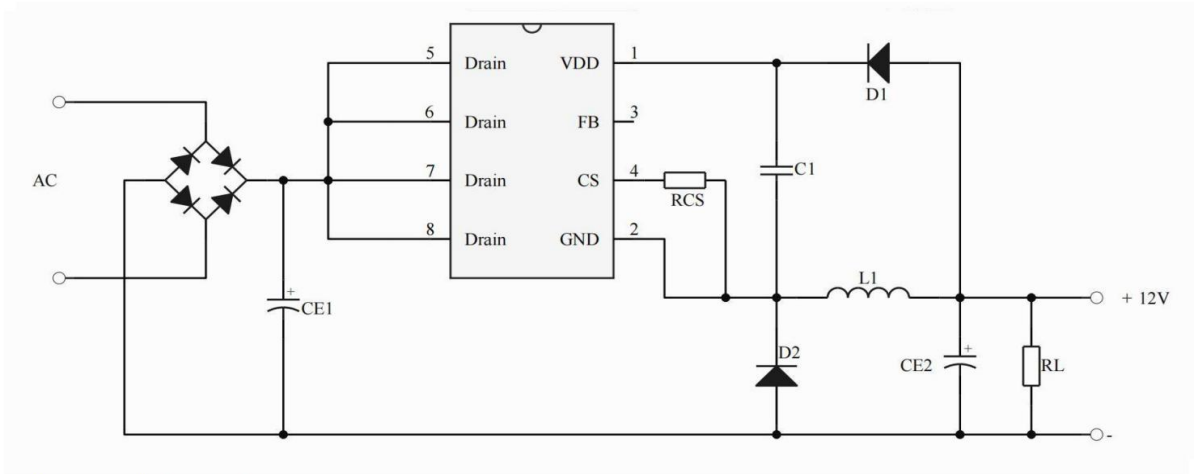
型号	订单型号	封装形式	打印方式	包装方式
KP1505	KP1505	SOP8		100/管 4000/盘



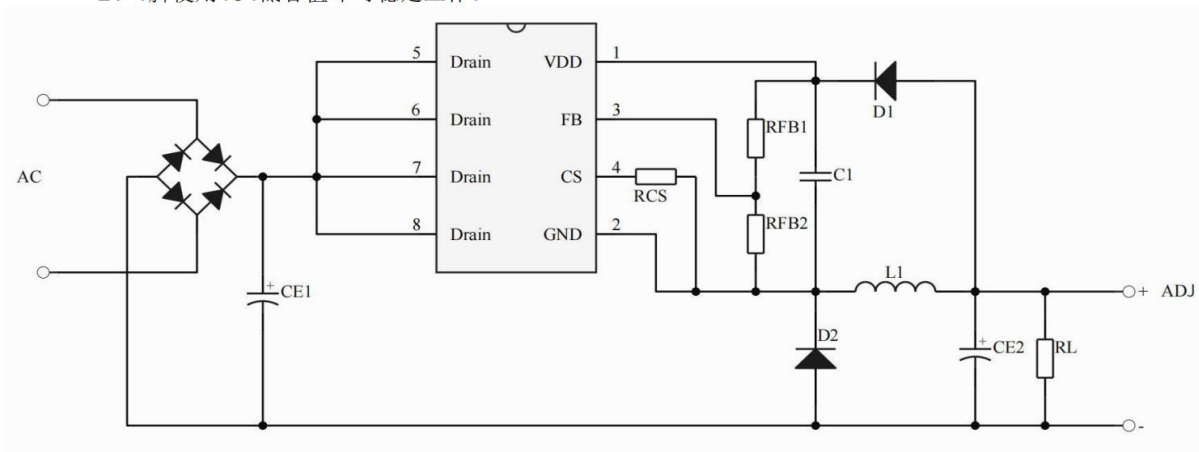
主要特点:

- 集成 650V 高压启动电路
- 多模式控制、无噪音工作
- 支持降压和升降压拓扑
- 默认 12V 输出（FB 脚悬空）
- 待机功耗低于 50mW
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能：
- 过载保护 (OLP)
- 逐周期电流限制 (OCP)
- 输出过压保护 (OVP)
- VDD 过压、欠压和电压箝位保护

典型应用电路：



- 优点： 1、输出固定12V；
2、1脚使用104低容值即可稳定工作。



- 优点： 1、输出电压可调；
2、1脚使用104低容值即可稳定工作。

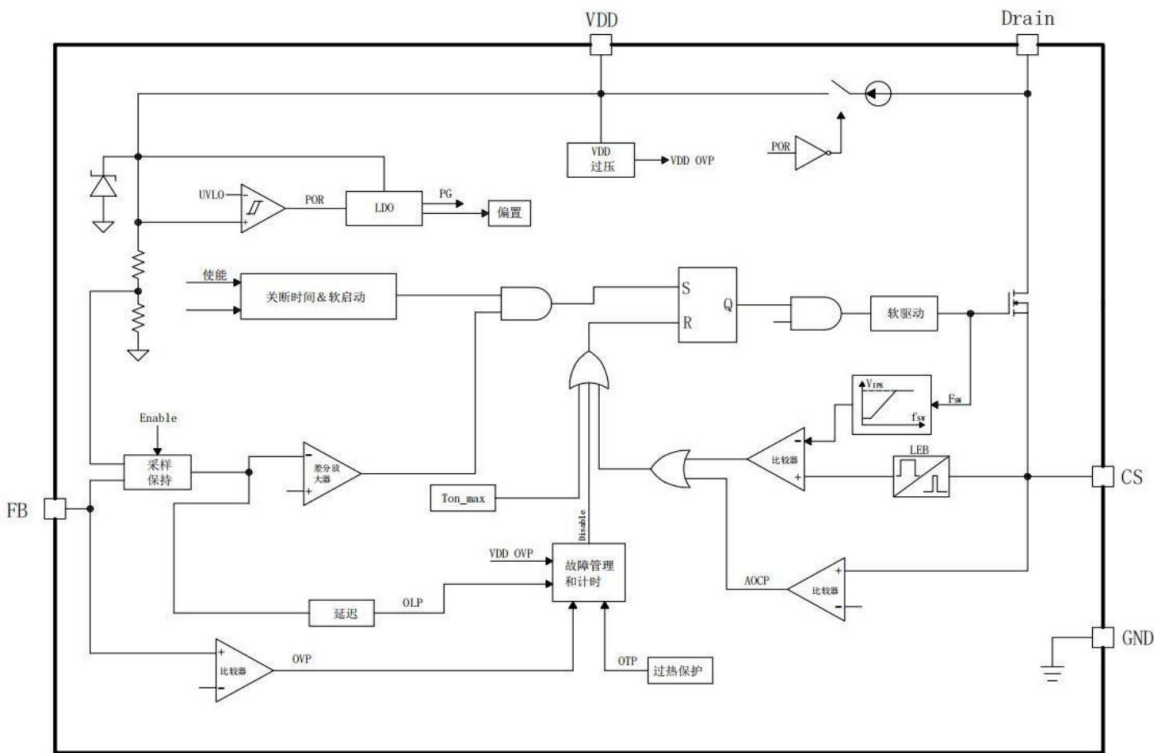
注： 1、典型应用电路及参数供参考，实际应用电路参数请在实测基础上设定，量产请和原厂沟通，其他不明请于我司工程师沟通联系。

- 2、输入电解电容(CE1)和续流二极管(D2) 根据实际使用电压、电流来调节。
3、RL建议负载电流为3~5mA，续流二极管建议使用肖特基。

管脚功能描述:

管脚	名称	I/O	描述
1	VDD	P	芯片供电管脚，同时作为输出电压反馈端（FB 悬空时）。典型应用中 VDD 电容推荐采用 100nF 贴片电容
2	GND	P	芯片的参考地
3	FB	I	反馈输入管脚，该引脚悬空时默认 12V 输出
4	CS	O	峰值电流检测管脚
5,6,7,8	Drain	P	内部高压 MOSFET 漏极

内部功能框图:



极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
Drain 管脚电压	-0.3 to 500	V
VDD 供电电压	25	V
VDD 箝位电流	10	mA
FB, CS 管脚电压	-0.3 to 7	V
封装热阻---结到环境(SOP-8)	165	°C/W
最高芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	KV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

注：针对静电敏感器件，操作时请注意ESD防护措施。

推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
工作环境温度	-40 to 125	°C
开关频率	40 to 60	kHz

电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
高压启动部分 (HV 管脚)						
I_{HV}	HV 脚供电电流	HV=500V, VDD=0V	1	2	—	mA
$I_{HV_leakage}$	HV 脚漏电电流	HV=500V, VDD=12V	—	—	10	uA
供电部分(VDD 管脚)						
V_{DD_ON}	VDD 开启电压		—	7.5	—	V
V_{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压		—	7.0	—	V
V_{DD_Reg1}	VDD 调制电压	FB 悬空	11.8	12	12.2	V
I_{VDD_st}	VDD 启动电流	无开关工作	—	100	300	uA
I_{VDD_Op}	VDD 工作电流	Fsw=60kHz	—	800	—	uA
I_{VDD_Q}	VDD 静态电流		—	200	—	uA
V_{DD_OVP}	VDD 过压保护阈值		—	25	—	V
V_{DD_Clamp}	VDD 钳位电压	$I_{VDD}=10mA$	—	27	—	V

反馈部分 (FB 管脚)						
V _{FB_REF}	内部差分放大器输入端基准		1.97	2.0	2.03	V
V _{FB_OVP}	输出过压保护 (OVP) 检测 阈值		—	2.4	—	V
V _{FB_OLP}	输出过载保护 (OLP) 检测 阈值		—	1.87	—	V
T _{D_OLP}	过载保护延迟时间		—	50	—	ms
电流检测输入部分 (CS 管脚)						
T _{LEB}	前沿消隐		—	350	—	ns
T _{D_OCP}	过流比较器延时		—	100	—	ns
V _{IPK}	峰值电流阈值		0.50	0.55	0.60	V
V _{AOCP}	异常过流保护检测阈值		—	0.9	—	V
计时部分						
T _{OFF_min_norm}	典型最短关断时间		14.5	16	17.5	us
T _{OFF_max_norm}	典型最长关断时间		—	1.4	—	ms
T _{OFF_max_FDR}	动态响应模式下最长关断时间		—	420	—	us
T _{ON_max}	最长导通时间		—	12	—	us
T _{ss}	内部软启动时间		—	3	—	ms
T _{Auto_Recovery}	自动恢复延迟时间		—	500	—	ms
过热保护						
T _{SD}	过热保护阈值	(备注 3)	—	150	—	°C
功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V _{BR}	功率 MOSFET 击穿电压		500	—	—	V
R _{dson}	静态导通阻抗	KP1505	—	9	—	Ω

备注 1：超出列表中“极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

备注 2：在超出以上参数的条件下，无法保障芯片的正常运行。

备注 3：参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

功能描述:

KP1505系列是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM 控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路，适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时，KP1505具有输出精度高和外围成本低的特点。

● 电流、电压调节

1. 电流估算公式: $I_{PK} = \frac{V_{IPK}}{R_{CS}}$
在典型应用中: $I_{PK} = \frac{0.55V}{1.5\Omega} = 0.37A$
2. 电压估算公式 $V_{OUT} = V_{FB} \times (1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}}) - V_{D2} + V_{D1}$

在典型应用中:

$$V_{OUT} = 1.87V \times (1 + \frac{6K\Omega}{3.3K\Omega}) - V_{D2} + V_{D1} \approx 5V$$

注: 电压计算会受续流二极管影响, 以实际调试为准。

● 超低静态工作电流

KP1505的静态工作电流典型值为 200uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求, 同时也可以提高系统效率。

● 高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)

KP1505内置有一个500V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作, 从 HV 端取电并通过高压电流源对

ADP1505系列芯片(典型)功能模块芯片所述工作VDD电压工作电流增加至约 0.8mA。在稳态工作时, 芯片通过反馈二极管由输出进行供电, 同时借助高压启动电路, 系统待机功耗可以低至 50mW 以下。

● 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

KP1505内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点, 并通过 CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当 CS 管脚采样到的电压超过该阈值时, 功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路(消隐时间约 300ns), 消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭 MOSFET。

● 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求, KP1505采用了调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合的工作模式, 如图 1 所示。

满载情况下系统工作于调频模式 (FM); 重载至轻载阶段, 系统同时工作于调频和调幅模式 (FM+AM) 中, 以达到良好的调整率和较高的系统效率; 当工作于空载附近时, 系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式, 可以将系统 待机功耗降至 50mW以下。

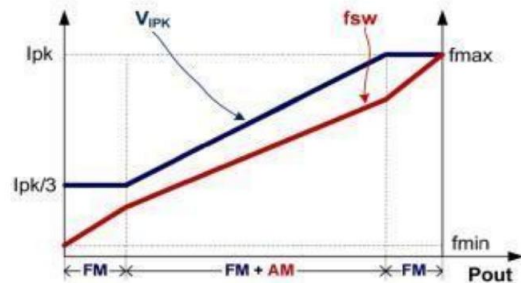


图 1

- 软启动

KP1505内集成有 4ms（典型值）的软启动电路，在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

- 输出过压保护（OVP）

当在连续的 3 个工作周期里 KP1505检测到 FB 脚电压高于 2.4V 以上时，芯片将进入输出电压过压保护（OVP），随后系统将进入自动重启模式。

- 过载保护(OLP)/短路保护(SLP)

当过流或短路情况发生时，输出电压和反馈电压将降低且低于输出过载保护阈值VFB_OLP。如果在 48ms（典型值）的时间内该状态持续存在，则芯片将停止开关动作并进入自动重启模式（如下描述）。

- 异常过流保护（AOCP）

过热保护(OTP)在某些情况下(如重载或者输出短路等)，系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏，芯片内部设计有异常过流检测模块（AOCP，典型阈值为0.9V）。当CS电压高于该阈值时，芯片进入降频工作状态。

- 过热保护(OTP)

KP1505内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温，当芯片结温超过150 °C（典型值）时，系统进入到自动重启模式。

- 优化的动态响应

KP1505集成有快速动态影响功能，可降低负载切换时的输出电压跌落。

- 消除可闻噪音

KP1505通过采用频率调制和 CS 峰值电压调制相结合的多模式控制方式，可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

- VDD 过压保护(OVP)和 VDD 电压箝位

当 VDD 电压高于 V_{DD_OVP} (典型值28V)时，芯片将停止工作。随后 VDD 电压下降至 V_{DD_Off} (典型值 7V)并进入重启模式。此外，芯片内部集成有 30V 稳压管，避免 VDD 脚电压过高而损坏。

- 自动重启保护

芯片触发保护后功率 MOSFET 将关断，同时系统进入自动重启模式，芯片内部的计时器开始工作。当计时器计时超过500ms 时，芯片将重置并重新开机。开机后若再次触发保护，则系统将再次进入自动重启模式。

- 软驱动电路

KP1505内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。

封装外形图:

